2E03

ピラジン環が縮環した TTF 誘導体を配位子とする

銅錯体の合成と物性及びその構造

(東大物性研¹, JST, CREST²) 市川俊^{1,2}, 木村伸也^{1,2}, 田島裕之¹, 森初果^{1,2}

[序論]

有機ドナーを配位子とする金属錯体はドナー由来の伝導性と配位金属由来の磁性の両方を 併せ持つと考えられており、非常に興味深い。中でも含窒素有機ドナーは窒素原子の高い配 位能を用いて金属イオンに配位させる試みが多くなされている。d- 相互作用の発現ために は金属 TTF間距離が短く、配位座である窒素部位が配位結合で結ばれていることが重要で あると考え、本研究ではピラジン環が縮環した TTF誘導体、BP-TTF (1)及び Pyra-TTF (2) を配位子とする銅錯体を合成した。さらにこれらの錯体の物性や構造について検討したので 報告する。

[実験]

ドナー分子1,2はそれぞれ次の合成スキームにより合成した。



金属錯体[CuCl₂(BP-TTF)] (3), [CuCl₂(Pyra-TTF)] (4) はドナー分子と TBA₂CuCl₄を拡散セ ルに入れ、さらに適当な溶媒を加え約二週間放置することにより合成した。また、伝導度測 定はカーボンペーストを用い交流四端子法で行った。

[結果及び考察]

拡散法による錯体作製の結果、3 は黒色針状晶として得られ、4 は黒色ブロック状晶と黒色 針状晶の二種類が得られた。3 と 4 の黒色ブロック状晶の X 線構造解析を行ったところ、3 は平面四配位でCu²⁺イオンがドナー分子を架橋してジグザク鎖を形成していることがわかっ た。また、ドナーは積層カラムを形成し ac 面内で 型配列をしていることが示された。4 の ブロック状晶も平面四配位であったが、3 とは異なり銅イオンとドナーが直鎖を形成してお り、ドナー分子は折れ曲がった配座を取りながら 1 次元カラムを形成していることがわかっ た。(図 1)



図 1. (a) [CuCl₂(Pyra-TTF)]の構造, (b) [CuCl₂(BP-TTF)]の c 軸投影図

3と4の二種類の多型について伝導度測定を行った結果、3は測定不能な絶縁体であったが 4のブロック状晶と針状晶はそれぞれ室温伝導度が約1.0×10⁻⁴ Scm⁻¹, 0.10 Scm⁻¹の半導体で あり、その活性化エネルギーはそれぞれ約0.33 eV, 0.15 eV であった。(図2)また3について ESR 測定を行ったところg値よりCu²⁺であることが示唆され、この錯体はドナー分子がほぼ 中性であるために絶縁体であると考えられる。



図 2. [CuCl₂(Pyra-TTF)]の電気抵抗率の温度依存性:(a)ブロック, (b)ニードル

さらに **3** については微結晶で、10 kOe を印加して SUQID による磁化率測定も行った。そ

の結果、ワイス温度が = -6.1 K となり、 $T_N = 4.4$ K で反強磁性転移が示唆された。 (図 3)このように本研究では含窒素 TTF に Cu^{2+} を配位させ超分子を形成することに よって新規 d- 系を開発することができ た。



図 3. [CuCl₂(BP-TTF)]の磁化率の温度依存性